#### MULTIPHOTON INTERFERENCE ALIGNER

Patent number: JP2004014866

Publication date: 2004-01-15

Inventor: OSAWA HISAO; FUJII TORU; OKI YASUSHI

Applicant: NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international: G02F1/39; G03F7/20; H01L21/027; G02F1/35; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/027:

G02F1/39; G03F7/20

- european:

Application number: JP20020167539 20020607 Priority number(s): JP20020167539 20020607

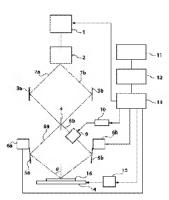
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a

Report a data error here

#### Abstract of JP2004014866

COPYRIGHT: (C)2004.JPO

multiphoton interference aligner capable of creating various exposure patterns using interference of multiple photons without requiring a reticle. SOLUTION: A pattern to form on a wafer is stored in a pattern memory 11 and an intensity/phase calculator 12 calculates the interference intensity at each incident angle [theta], the phase between two light beams, and the angular variation of interference reflectors 5a and 5b based on that information. Based on the output from the intensity/phase calculator 12, a synchronization controller 13 transmits the angular variation of the interference reflectors 5a and 5b to reflector controllers 6a and 6b in order to vary the angle of the interference reflectors 5a and 5b. At the same time, the interference intensity is transmitted to an exposure light source 1 in order to regulate the exposure and the phase variation is transmitted to a phase modulation controller 10 in order to vary the optical phase difference between two light beams by driving a phase modulation element 9. These operations are performed by varying the incident angle [theta] for a required amount in a desired mode, and the wafer is exposed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特**開2004-14866** 

(P2004-14866A) (43) 公開日 平成16年1月15日(2004.1.15)

(51) Int. Cl. 7	F I		テーマコード (参考)
HO1L 21/027	HO1L 21/30	515D	2K002
GO2F 1/39	GO2F 1/39		5FO46
GO3F 7/20	GO3F 7/20	521	

#### 審査請求 未請求 請求項の数 7 〇L (全 12 頁)

特願2002-167539 (P2002-167539) 平成14年6月7日 (2002.6.7)	(71) 出願人	000004112 株式会社ニコン
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
	(74) 代理人	100094846
		弁理士 細江 利昭
	(72) 発明者	大澤 日佐雄
	,	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
	(72) 発明者	藤井 透
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
	(72) 発明者	大木 裕史
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
	Fターム (参	考) 2K002 AA04 AB12 BA03 HA21
		最終頁に続く
		平成14年6月7日 (2002.6.7) (74) 代理人 (72) 発明者 (72) 発明者 (72) 発明者

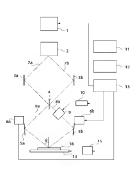
(54) 【発明の名称】 多光子干渉露光装置

## (57)【要約】

【課題】様々な露光パターンを、レチクルを使用せず、 多光子の干渉を使用して作り出すことが可能な多光子干 渉魔光装置を提供する。

【解決手段】 パターン記練装置 1 1 にはウエ人上に形成 した11パターンが記憶されてあり、強度・位相計算装置 1 2 はでの体報を基に、各入制角のに対して干渉強度、 2 光東間の位相、干渉用反射鏡ら。。 5 6 の角度を化量 を計算する。同期制御検置 1 3 は強度・位相計算検置 1 2 の出力を拡て、干渉用反射鏡ら。。 5 6 0 角度を低量 を反射鏡刺御装置 6 6。 6 6 に伝え、干渉用反射鏡ら。 、5 6 0 角度を変化させる。 同時に、干渉独庭を輩光光 第1 に伝えて露光量を調整し、 位相変化量を枢相変調割 都装置 1 0 に伝え位相受調整、7 を駆動して2 光東間の 光位相差を変化させる。 つれらの動作を所望のパターン において必要が送け入射角6 を変化させながらウエ人上 に繋光を行う。

【選択図】 図1



30

40

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

光渡と、当該光源からの光子を異なる光路を通る $n(n \ge 2)$ 個のコピーレントなの光子 状態に交換する多光子生成手段と、n/2光子田に分岐された多光子を異なる光路かま 透過鏡上に投射し、n光子にする第1の光学系と、当該半透過鏡を通過又は反射して、再 ひ異なる光路を進む前記n光子を露光面上で合成し、干渉編を形成する第2の光学系を有 する多光子干渉数光接電であって、前記第2の光学系において、前記螺光面上に名光子 別連する豚の螺光面となす角度が可登とされていることを特徴とする多光子干渉電光接電

# 【請求項2】

請求項1に記載の多光子干渉露光装置であって、前記第2の光学系は、当該第2の光学系 に含まれる反射鏡の角度を変化させるごとで、前記露光面上に各光子が到達する際の、前 記露光面となす角度を調整する機能を有することを特徴とする多光子干渉露光装置。

#### 【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載の多光子干渉電光装置であって、前記第2の光学系は、要求 される露光パターンのフーリエ委換後の強度に応じて、前記電光面上に各光子が到達する 際の電光面となす角度毎の電光量を調整する機能を有することを特徴とする多光子干渉電 光装置。

## 【請求項4】

請求項1から請求項8のうちいずれか1項に記載の多光子干渉電光装置であって、前記第 2の光学系は、要求される電光パターンのフーリエ変換後の位相に感じて、前記電光画上 たみそが到達する際の電光画となす角度毎の2つの光束の位相差を調整する機能を有す 3でとを特徴とする多光子干渉電光装置。

## 【請求項5】

itま項1から請求項3のうちいずれか1項に記載の多光子干渉電光装置であって、前記第 2の光学系は、要求される電光パターンのフーリエ交換後の位相に応じて、前記電光面上 に名光子が到達する際の電光面となす角度毎に、結像面に置かれた電光面の位置を変える 機能を有することを特徴とする多光子干渉電光装置。

#### 【請求項6】

請求項1から請求項5のうちいずれか1項に記載の多光子干渉電光装置であって、前記光 子均生成手段が、非線形光学現象により光子を異なる光路を通る光子均に変換する非線形 光学結晶を有するでとを特徴とする多光子干渉電光装置。

#### 【請求項7】

請求項 6 に記載の多光子干渉魔光装置であって、前記非線形光学现象がパラメトリックダウンコンパージョンであることを特徴とする多光子干渉魔光装置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は多光子干渉露光装置に関するものである。

# [0002]

#### 【従来の技術】

従来技術による電光装置の艦略を、図2を用りて説明する。従来技術による電光装置は、少なくとも、電光の左めの状を発生する光源101、光源からの光をレチクルに照射する 照明光学系102、レチクルとウエ人の間の相対位置を調整するためのアライメント光学 系103、レチクルを透過した光をウエ人に投影する投影光学系110、レチクルで置を制御するレチクルステージ制御機構104、ウエ人ステージ制 が105、レチクル位置を制御するレチクルステージ制御機構104、ウエ人ステージ1 都機構109を備えている。

#### [00003]

レチクルステージ105にはレチクル105のか置かれ、ウエハステージ108上にはウ

20

30

50

エハ108のが置かれ、レチクル105のとウエハ108のはそれぞれ投影光学系110 の物体面、像面となるように投影光学系110との位置関係が調整されている。

[0004]

露光光源101からの光は照明光学系102を通りレチクル105のを照明する。レチク ル 1 0 5 a 、 投影光学系 1 1 0 、 及びウエハ 1 0 8 a が上記の関係にあるためレチクル 1 05 のを透過した光は投影光学系110でウエハ108の上に結像し、ウエハ108の上 に感光削が塗布されていれば、レチクルのパターンをウエハ108の上に転写することが できる.

[0005]

通常、投影光学系で転写できる面積はウェム全面に比べ小さいため、レチクルステージ1 05とウエハステージ108により、それぞれレチクルとウエハの水平位置(光軸と垂直 な面内の位置)を制御することで、ウエハ全面にレチクルパターンの転写を行えるように してある。このとき、ウエハ全面における転写パターンはウエハ全面において異なるパタ ーンでもよいし、同一レチクルパターンの繰り返しでもよい。

[0006]

ところで、通常の露光装置では、光の回析限界がちの制約により形成できるパターンの周 期に下限があることが知られている。すなわち、照明光の波長をえ、光学系の開口数をN Aとすると、形成できるパターンの周期の下限は光の回析限界から

 $P_{m+n} = \lambda / (2NA)$ 

となり、これよりも微細な加工を行うことは原理的に不可能であった。

[0007] 一方で、回路パターンの微細化に伴い露光装置に要求される露光線幅、周期は年々微細化 してきているため、上記の限界の範囲内でされに対応するために、光学系の開口数NAを 大きくするとともに照明波長んの短波長化が進められてきた。しかしながら、現在すでに 光学系の開口数NAは大気中で使用する場合に上限となる1.0に極めて近づいている。 さらに照明光に関しても、既に真空紫外光とも言える波長 1 5 0 n m 程度の光が利用され つつあるため、露光光学系を構成するためにされまで用いられてまた多くの光学材料が、 透過率の点がら利用不可能となり、光学設計の選択の幅が狭くなってきている。このため 、要求される微細パターンを形成するために必要な性能を持った光学系の設計が非常に困 難となってきている。

[0008]

この問題を解決するために、多光子干渉を利用した露光装置が考案された。詳細はPLY S. Rev. Lett. 85 P2733-2736 (2000) に記載されている。 この原理に従って構成された多光子露光装置の原理を、図3を用いて説明する。

[0009]

図3において、露光光源1からのレーザー光を非線形光学結晶2に入射する。ここで、露 光光源1としては非線形光学現象を起こしやすいコヒーレントな光を発生する光源、すな わちレーザー光源から構成されている。非線形光学結晶2は、パラメトリックダウンコン パージョンにより露光光源からの光の波長(入」)の2倍の波長(2入」)の光が発生す るように調整されている。これは、パラメトリック発振におけるシグナル光とアイドラ光 の波長が等しい特別な状態である。従ってこの過程で出てくる光子は必ず位相のそろった 波長の等しい光子対をなす。

[0010]

すらに、非線形光学結晶2でのこの過程により発生する光の進行方向すこの光子対の一つ 一つが別々となるように設定しておけば、図3の光路70、76を通るようにできる。光 路7a、7bに進んだ光は、反射鏡3a、3bにより半透過鏡4の同一点に入射するよう にされている。一般に光は自分自身としが干渉しないが、この場合は全く同じエネルギー 、同じ位相を持った光同士であるため、2つの光路を進行してきた光の間で干渉が起こり 、半透過鏡4の反射率、透過率がそれぞれ50%の時には、いわやるエンタングルドステ ートにある光子が光路8a、8bを進むことになる。すなわち、光子対が光路8aを通る 状態と光路86を通る状態の重ね合わせ状態となる。

## [0011]

これら光子対は干渉用反射鏡5の、56で反射され、ウエハステージ108上に搭載されたウエハ108の上回の一点に入射する。その結果、ウエハ108の上回で2光子状態の干渉が起こり、干渉籍ができる。光子対か対のまま光路8の、86のどちらを通ってきたか刊別がつかない状態であるために2光子状態での干渉を起こすのである。これは、通常の干渉計において1つの光子が2つの光路のどちらを通ってきたが刊別ができないたのに干渉が起こすると何様である。

# [0012]

ごこで形成される干渉籍の周期  $P_2$  は、  $2\lambda_1=\lambda_2$  とおくと、これら光子の入射角  $\theta$  に対して、

 $P_2 = \lambda_2 / (4 \sin \theta) = \lambda_1 / (2 \sin \theta)$ 

となる。これは、波長入2の光を発生する光源を用りた場合の、通常の光干渉で得られる 干渉箱の周期P<sub>1</sub>

 $P_1 = \lambda_2 / (2 \sin \theta)$ 

と比べて周期が1/2になっており、従来の露光装置では決して形成することのできなかった微細加工が可能となっている。

## [0018]

以上、2光子干渉について説明したが、もし上記2光子状態をn光子状態とすることができれば、干渉縞の周期はさらに狭くすることができて、その周期Pnは、

 $P_n = \lambda / (2nsin\theta)$ 

となる。n光子状態はパラメトリック発振器を多段につなぐことで生成可能である。

[0014]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図8に示す従来の多光子露光装置では、露光面に到達する光子の入射角  $\theta$  が固定であるため、干渉により形成される干渉福の周期が単一となり、様々な露光パターンに対応させることが非常に困難であるという問題があった。本発明はこのような事構に鑑みてなされたもので、様々な露光パターンを、レテクルを使用せず、多光子の干渉を使用した多光子干渉露光装置を提供することを課題とする。

#### [0015]

## 【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するための第1の手段は、光源と、当該光源からの光子を異なる光路を通るn(n≥2)個のコピーレントなn光子状態に変換する多光子生成手段と、n/2光子配に分岐すれた多光子を異なる光筋がよ半透過境上に投射し、n光子にする第1の形と、当該半透過鏡を通過又は反射して、再び異なる光路を進む前記n光子を露光面上でない、干渉縞を形成する第2の光学系を有する多光子干渉露光設置であって、前記第2の大学系において、前記電光面上に各光子が到速する際の電光面となす角度が可変とされていることを特徴とする多光子干渉電光接置(請求項1)である。

#### [0016]

本手段の作用を説明するに先立ち、その前提となる一般的な部分コとーレント結像条件の 下での結像について述べる。

[0017]

一般的に、周波数領域での位置ペクトルをV、V`とし、2つの光の瞳中での強度分布のフーリエを換をサれずれ.

[0018]

【数1】

# $\tilde{O}(v), \; \tilde{O}(v')$

[0019]

10

20

30

20

30

40

```
とすると、この2つの光線の干渉による結像面上の強度分布は、結像面での位置ペクトル
をととして、
[0020]
【数 2 ]
I(r) = \int \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \tilde{O}^*(v) \tilde{O}(v') R(v, v') e^{i(v-v') \cdot r} dv dv' \qquad \cdots (1)
[0021]
となる。ここで、
[0022]
【数3】
\tilde{O}^*(v)
[0023]
[0024]
【数41
\tilde{O}(v)
[0025]
の複素共役数であり、(V=V`)・とは(V=V`)ととの内積、R(V、V`)は、
投影光学系のTCC (Transmission of Cross Coeffici
ent) である。また、
(1)式の積分範囲は、瞳座標内である。
[0026]
(1) 式には様々な空間周波数の成分が入っているので、
とすれば、(1)式は
[0027]
I(r) = \iint_{C} \tilde{O}^*(v)\tilde{O}(v-C)R(v,v-C)e^{iC\cdot r}dvdC \qquad \cdots (2)
[0028]
と書くことができるため、像面での光強度は、空間周波数でごとに様々な強度と位相を持
つ手渉縞の積分ソレフソらえスクソがプまる。空間周波数CP園レフは露光領域の長さす
L とすると 2 元 / L が 最低 周波数 となり、 この 周波数 で量子 化した 周波数 で級数展開がで
きるので、 (2) 式は、以下の形に展開できる。 ただし、 C n = 2 n π/ L である。
[0029]
[ # R ]
I(r) = \sum_{C} \int_{v} \tilde{O}^{*}(v) \tilde{O}(v - C) R(v, v - C) e^{iC \cdot r} dv \quad \cdots (3)
```

[0080] これは、形式的に [0031] 【数7】

20

30

50

$$I(r) = \sum_{C_n} |I(C_n)| e^{i\phi(C_n)} e^{iC_n \cdot r} \qquad \cdots (4)$$

[0032]

と書くことができる。このことは、

振幅が | I ( C <sub>n</sub> ) | であり、 位相が φ ( C <sub>n</sub> ) である干渉箱を周波数 C <sub>n</sub> ごとに用意で きれば、光干渉を利用して所望の k ターカを り工八の上に投影できることを意味している 。ここで、 周波数 C 。毎に用意する干渉箱の編集と位相は、

[0033]

【数8】

$$|I(C_n)|e^{i\phi(C_n)} = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{O}^*(v)\tilde{O}(v-C_n)R(v,v-C_n)e^{iC_n\cdot r}dv \quad \cdots (5)$$

[0034]

のように、光源の強度分布のフーリエ変換

[0085]

【数9】

$$\tilde{O}(v)$$

[0036]

と、 想定している投影光学系のTCCであるR(V、Cn) から計算できる各係数を、 絶対値と位相因子に分けることで容易に求めることができる。 ここでの位相因うは 機画での位相をもなしているが、光干渉の際には、 2 光束の位相差がこれと等しいため、 2 光束の一方の位相を他方に対して 4 (Cn) ずらすことで達成することができる。

[0037]

2 光束をウエハ上で干渉させる場合これら2 光束がなす角を2 0 とすると、

 $2 \sin \theta = |C| = |V - V'|$  (6)

[0088]

。。。。。。 よって、1次元パターンに限れば、一方の光の位相を可変とした2光束干渉によって所望 のパターンをウエ八上に形成することができる。

[0039]

実際には、I(と)が決定されると、それを(5)式に対応するようにフーリエ級数に展開することにより、Cn毎に振幅である II(Cn) | と位相差を(Cn)を求める。 | I(Cn) | が、Cnが与えられたときの投影光学系の強度(光源の強度×露光時間)に対応する。Cnを与える2光束のなす角は、(6)式により決定する。

[0040]

また、R ( V 、 V ' ) としては、理想的な投影光学系のものを持ってくればよく、やれは中心位置が座標 V 、 C ー V にある半径N A の円と、中心位置が座標( 0 . 0 )半径 σ X N A の円全てが重なった領域の面積であるため容易に計算できる。ここで、 σ は 照明光学系 の コピーレンス 度 である。

[0041]

[0042]

2次元の像形成の場合は、感光材料の感光が光強度の積分強度に比例するため、2光東光 干渉による像形成を、結像面を回転させながら行うことでも可能である。

#### [0048]

以上は通常の1光子吸収過程を述べたものであるが、2光子吸収の場合も式(2)は同様であり入射角と光強度、位相の関係を求めることができる。 ただし、2光子吸収を利用した場合には1光子吸収過程と同じ入射角であってもされによって生成される干渉箱の周期は1/2になるため、(6)式の代わりに

 $4 \text{ s i n } \theta = |C| = |V - V'|$  (7)

を使用することになる。

## [0044]

なお、本手法で非常に大きなパターン(低い空間周波数を持ったパターン)を形成するには2光束間の角度を非常に小さくしなければならず、接置が大型化するおやれがあるが、 せのような大きなパターンの形成には従来の低解像度露光接置を用いることで可能である ため大きな問題とはならない。すなわち、パターン中の空間周波数に応じて本手法と従来 の電光接置を使い分ければよい。

[0045]

本手段においては、このような原理に基づき、霧光面に到達する光子の入射角が可変とされているので、このような原理に基づき、入射角を変化させながら、各入射角ごとの霧光 して、変光時間の少なくとも一方)を変化させることで、自動とする様々などッチの電光パターンを露光面に形成することができる。すなわち、本手段においては、多光子手渉により、所望のパターンをウエハ等の基板上に形成しているので、レチクル等を必要とせず、 かっ、レチケル等に形成されたパターンを異光転写する場合に比して、 微細なパターン マ 英根上に形成することができる。

[0046]

また、本手段においては、光子対生成により生成された光子対を干渉させて干渉箱を作り出しているので、光子対と同一の波長の通常の光線を2つに分けて干渉させる場合に比して、干渉箱のピッチを細かくすることができる。

[0047]

前記課題を解決するための第2の手段は、前記第1の手段であって、前記第2の光学系は、当該第2の光学系に含まれる反射鏡の角度を変化させることで、前記露光面上に各光子 が到達する際の、前記露光面となす角度を調整する機能を有することを特徴とするもの( 聴求項2)である。

[0048]

本手段においては、前記第2の光学系に角度が可委な反射鏡が含まれており、 やれにより、 第1の手段で述べた入射角を可変することができる。よって、反射鏡の角度を変化させ ることにより、所望のこ,を形成することができる。

[0049]

前記課題を解決するための第3の手段は、前記第1の手段又は第2の手段であって、前記 第2の光学系は、要求される電光パターンのフーリエ変換後の強度に応じて、前記電光面 上に各光子が到達する際の電光面となす角度毎の電光量を調整する機能を有することを特 徴とするもの(請求項3)である。

[0050]

本発明においては、前記露光面上に各光子が到達する際の露光面となす角度毎の露光量を 調整する機能を有するので、前記第1の手段で説明したC,毎に「I(C,)「を変化させることができ、所望のピッチのパターンを所望の強さで露光面上に形成することができ ス。

[0051]

前記課題を解決するための第4の手段は、前記第1の手段から第3の手段のいずれかであって、前記第2の光学系は、要求される露光パターンのフーリエ変換後の位相に応じて、前記電光面上に各光子が到達する際の電光面となり角度毎の2つの光束の位相差を調整する機能を有することを特徴とするもの(請求項4)である。

[0052]

10

30

本手段においては、前記露光面上に各光子が到達する際の露光面となす角度毎の2つの光 束の位相差を調整する機能を有するので、前記第1の手段で説明したこ。毎に位相差φ( C、)を調整することができ、所望のパターンの位相を変化させることができる。特に、 要求される露光パターンのフーリエ変換後の強度に応じて、前記露光面上に各光子が到達 する際の露光面となす角度毎の露光量を調整しながら、同時に位相差を変化させて、C。 毎に露光を行って重ね合わせることにより、様々などターンを被露光面上に形成すること かできる。

[0058]

前記課題を解決するための第5の手段は、前記第2の光学系は、要求される露光パターン のフーリエ交換後の位相に応じて、前記電光面上に各光子が到達する際の電光面となす角 度毎に、結像面に置かれた露光面の位置を変える機能を有することを特徴とするもの(請 求項5)である。

[0054]

前記第4の手段においては、結像面に形成される干渉縞の位相の調整を、2つの光束の位 相差を変えることによって行っていた。本手段はこの代わりに、結像面に置かれた雲光面 の位置を、C。毎に代えることによって、干渉縞と被累射対の結像面との位相関係を変化 させ、前記第4の手段と等価な関係を作り出している。

前記課題を解決するための第6の手段は、前記第1の手段から第5の手段のいずれかであ って、前記光子対生成手段が、非線形光学現象により光子を異なる光路を通る光子対に変 換する非線形光学結晶を有することを特徴とするもの(請求項6)である。

[0056]

本手段においては、比較的簡単な手段により光子対を生成することができる。

[0057]

前記課題を解決するための第7の手段は、前記第6の手段であって、前記非線形現象がパ ラメトリックダウンコンパージョンであることを特徴とするもの(請求項7)である。 [0058]

本手段においては、比較的簡単な手段により光子対を生成することができる。

[0059]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態の例を、図を用いて説明する。図1は、本発明の実施の形態の 1 例である多光子干渉照明装置を利用した露光装置の光学系の概要を示す図である。露光 装置は、露光光源1、非線形光学素子2、反射鏡3a.3b、半透過鏡4、光干渉用反射 鎌 5 a., 5 b., 及びその制御装置 6 a., 6 b., 位相変調素子 9.、及びそのドライバ 1 0.、 パターン記憶装置11、強度・位相計算装置12、同期制御装置13、ウェルステージ1 4、及びその制御装置15からなる。ウエ人ステージ14上には、感光剤を塗布したウエ 八16炒載サられている。

[0060]

露光光源1からのレーザー光を非線形光学結晶2に入射する。ここで、露光光源1として は非線形光学現象を起こしやすいコピーレントな光を発生する光源、すなわちレーザー光 源から構成されているのが望ましい。非線形光学結晶2は、パラメトリックダウンコンパ ージョンにより露光光源1からの波長の2倍の波長の光が発生するように調整しておく。 これは、パラメトリック発振におけるシグナル光とアイドラ光の波長が等しい特別な状態 である。従ってこの過程で出てくる光子は必ず位相のやろった波長の等しい光子対をなす

[0061]

さらに、非線形光学結晶2でのこの過程により発生する光の進行方向をこの光子対の一つ 一つが別々となるように設定しておくことで、図1の光路7の、7bを通るようにできる 光路 7 a. 7 b に 進ん だ 光 は 反 射 鏡 3 a. 3 b に よ り 半 透 過 鏡 4 の 同 一 点 に 入 射 す 3 よ す に調整し フおく。 一般 に光は 自分 自身 とし か干渉 しないが、 この 場合は全く 同 け エネル ヤー、同じ返来(波の形)を持った光同士であるため、2つの光路を進行してきた光の間で干渉が起こり、半透媚弾4の反射率、透過率が弋れぞれ50%のときには、いわゆるエンタングルドステートにある光子対が光路8の、81を進むことになる。即ち、光子対が光路8点を通る大野ス状態との電ね合わせ状態となる。

#### [0062]

これ5光子は干渉用反射鏡5 a. 5 b で反射され、ウエハステージ14上に搭載されたウエハ16上の同一点に入射する。 やの結果、ウエハ16上面で2光子状態での干渉が起こり干渉舗ができる。光路8 b 側には位相を調素子9 が設けられており、光路8 b 側を通る光めな位相を変化させられ、その位相差に応じてウエハ13上で干渉を起こした際にその干渉編の位相が変化する。その結果、露光面上での干渉編の位置が変化する。

## [0063]

パターン記憶狭置 1 1 にはウエハ上に形成したいパターンが記憶されており、強度・位相計算装置 1 2 はせの情報を基に式 (4)、式 (5) を使って、名入射角 $\theta$ に対して干渉強度、2光末間の位相、干渉用及射鏡5  $\alpha$ 、5  $\delta$  の角度変化量を計算する。

## [0064]

同期制御装置13は強度・位相計算装置12の出力を基に、干渉用反射鏡5点、55の角度を化量を反射鏡制御装置6点、65に伝え、干渉用反射鏡5点、55の角度を変化させる。同時に、干渉強度を露光光源1になって露光量を調整し、位相を化量を位相を調制制度10に伝え位相変調素チ9を駆動して2光束間の光位相差を変化させる。これらの動作を所望のパターンにおいて及要なだけ入射角8を変化させながらウエ八上に露光を行う

## [0065]

ところで、本実施例によるパターン形成手法であらゆる空間周波数をもったパターンを露光しようとすると1度に露光できる面積が限られる。干渉すべき2つのピームが完全に分離しているところに半透過鏡4を置かなければならないこと、最低空間周波数ではその波長がパターンサイズと等しいことを考慮して計算すると、一度に露光できる幅Wはおおよっ

# $W = (L\lambda/2)^{-1/2}$

従って、霧光パターンのうち 5名周波成分は 従来の電光接置に任せ、本技術による電光では 高周波成分 を担当するのが望ましいが、すべての電光を本電光接置で行う場合には、ウエ ハステープ 割御装置 15 によりウエハステージ 14 专上記幅wごとにずらしながら、ステ ップアンドリピート方式により露光を行っていけばよい。

## [0067]

図 1 では、位相変調素子9 は光路8 5 にのみ入っているが、光路8 0 ののみ、又は光路8 0、 8 5 の両方に入れることもできる。両方の光路に入れる場合は、両者の位相変調量の差 を上記の位相変調量とすれば目的は煌成できる。

#### [0068]

光瀬として時間コとーレンスがやや軽い光源を用いた場合には両方の光路に同じ大きさの 位相を調素子を入れることで光路長をほぼ等しくすることができ、干渉性を改善すること ができる。

#### [0069]

また、上記の実施の形態では、各入射角 $\theta$  ごとに変化する干渉強度の調節を、露光光源 1 に制御を加えることで行っているが、繋光光源 1 の強度を一定に保ったまま各入射角における干渉用反射鏡 5 丸、5  $\delta$  の滞留時間で制御を行ってもよい。あるいは、上記の露光を連続的に入射角を変化させながら行う場合には、干渉用反射鏡 5 丸、5  $\delta$  の角度変化の速度に制御を加えて行ってもよい。

#### [0070]

10

# 【発明の効果】

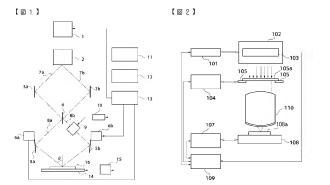
以上説明したように、本発明によれば、様々な露光パターンを、レチクルを使用せず、多 光子の干渉を利用した多光子干渉露光装置を提供することができる。

#### [0071]

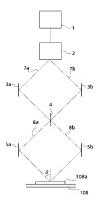
- 【図面の簡単な説明】
- 【図1】本発明の実施の形態の一例の光学系の概要を示す図である。
- 【図2】従来の露光装置の概要を示す図である。
- 【図3】従来の多光子干渉電光装置の概要を示す図である。

# 【符号の説明】

- 1: 電光光源、2: 非線形光学素子、3 a. 3 b: 反射鏡、4: 半透過鏡、5 a. 5 b: 10 光干渉用反射鏡、6 a. 6 b: 反射鏡制御装置、7 a. 7 b: 光路、8 a. 8 b: 光路、
- 9: 位相変調素 5 、 1 0 : 位相変調素 5 ドライパ、 1 1 : パターン記憶接置、 1 2 : 強度 ・ 位相計算 接 置、 1 3 : 同期 制御 装 置、 1 4 ・ ウエハステージ、 1 5 : ウエハステージ制 御装置、 1 6 : ウエハ



[ 23 ]



フロントページの続き

F ターム(参考) 5F046 BA08 CA03 CB02 CB25 CC01 CC04 DA01 DA02